

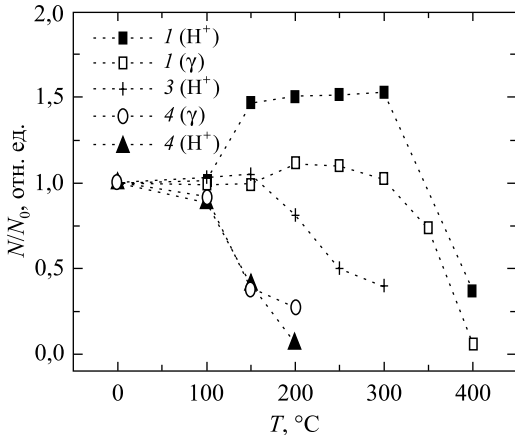


Рис. 5. Зависимость концентрации радиационных дефектов, соответствующих пикам DLTS на рис. 3, от температуры изохронного (20 мин) отжига. Вид облучения указан в скобках

Fig. 5. The dependence of radiation defects concentration, corresponding to DLTS peaks in fig. 3, from the temperature of isochronous (20 min) annealing. The type of exposure is indicated in brackets